中国滚光 第13卷 第10期

10W横向流动准分子激光器

楼祺洪 郑承恩 江 淼 姜阅清 丁泽安 丁爱臻 董景星 魏运荣 祁建平 王润文 (中国科学院上海光机所)

提要:本文报道了输出功率为 10 W 的紫外(308 nm)横向流动准分子激光器。 给出了气体循环系统特性和 X 射线预电离剂量分布;最后,讨论了气体流速对激光 输出的影响。

A 10 W transverse flow excimer laser

Lou Qihong, Zheng Chengen, Jiang Miao, Jiang Yueqing, Ding Zean Ding Aizhen, Dong Jinxing, Wei Yunrong, Qi Jianping, Wang Runwen

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: A transverse flow excimer laser produces an output power of 10 W at 308nm. The gas recirculating system and the dosage distribution of X-ray preionization are described, and the effects of gas flow velocity on the laser output are rediscussed.

在有些应用中,有时候需要脉冲能量较 大(焦耳量级)、平均功率为几瓦的准分子 激光器件。本文报道最大输出功率为10W 的紫外(308nm)横向流动准分子激光器。

气体流动系统

图1给出气体循环流动系统的结构简 图,离心风机由功率为2kW的马达驱动,马 达与离心风机之间采用高压旋转密封系统。 系统由不锈钢制成以防止卤素气体的腐蚀, 在激光放电区下游有一个管板式水冷热交换 器。为了防止离心风机转动时的振动对整个 系统(主要是激光放电区)的影响,离心风机



的入口端与出口端均有不锈钢波纹管与系统 连接。

激光室部分的气体流量控制是采用减小 边界层的喷管设计。阳极取张氏电极形状, 并嵌入环氧玻璃钢板中; 阴极是一个平面型 电极,其背后是X射线预电离源。二电极之 间的间距为2.5 cm。

整个气体流动循环系统由不锈钢加工而 成,用皮托管测量了放电区的流速,最大流速 可达每秒 30 m以上。图2给出长度为70 em 的激光放电区沿光轴方向的流速分布。图中 分别给出直流电机驱动电压为100 V和 150 V 时的流场分布。实验结果表明流场对于放电 区沿光轴方向的中心是对称的,图2 仅给出 一半的流场分布。



图 2 激光放电区内的流速沿光轴的分布, 电压值表示离心风机直流马达的驱动电压

从图 2 可见,虽然在直流马达驱动电压 为 150 V 时,流速分布有一定的起伏,但仔细 的计算表明,在 150 V 和 100 V 情况下, <u>4V</u> 值均为 0.13 左右。但 100 V 情况下流场分 布更平坦。上述结果表明,本实验设计的气 体循环流动系统具有良好的流场分布。

二、X射线预电离源 及其剂量分布

在激光放电阴极背面 是一个 冷阴极 X 射线源^[4], 冷阴极电子枪的阴极宽 0.6 cm 长 60 cm 安装在一根铜制防晕盖上,它与电子 枪阴极间距为1.5 cm 左右,阴极是用薄的 钽箔制成, 包箔后面是厚度为0.15 cm 的铝 板。钽箔的厚度选择为既能适当地阻止电子 的穿透而对 X 射线又有良好的穿透性能。为 了使 X 射线颈电离源能在重复频率下运转, 钽的良好的传导热的性能有助于热量的扩散 传导。三级麦克思发生器提供一个 100 kV、 500 ns 的宽脉冲。在激光放电区测得每个脉 冲的 X 射线强度约为 5 m Rem 左右。

为了控制 X 射线的辐射 范围,在激光 放电阴极背面有一块通 X 光孔 径 为 1 cm × 60 cm 的掩模板,图 3 给出 X 射线在空间分 布的几何结构,斜线部分表示 X 射线通光孔 径,用虚线表示的圆柱体为激光振荡谐腔区 域,而 X、Y 和 Z 轴则表示我们测量三个座 标方向上的 X 射线剂量分布的方位。



图 3 测量激光放电区内 X 射线剂量 分布的座标系统

采用北京核仪器生产的 FJ-301G₂ 型射 线剂量仪,测量了三个座标方向的 X 射线剂 量分布。图 4 给出沿 Z 轴方向上的分布,其 均匀度约为 ±25%,这对于大体 积 准 分子 雪崩均匀放电已足够均匀。图 5 给出 X 射 线剂量沿 X 轴和 Y 轴的分布,在 Y 方向, 10 cm 范围内剂量减小小于 25%,而在 X 方 向 10 cm 范围要减小 4~5倍。但在我们的 激光器设计中,极间距仅为 2.5 cm,在该区域 内 X 射线剂量亦小于 25%。综上所述,在



图 5 X 射线剂量沿 X 轴和 Y 轴方向的分布 激光放电区范围内, X 射线剂 量 变 化 小 于 ±25%,为大体积均匀放电提供了必要的条 件。

三、激光实验结果

激光放电电源是用一台电容量为

0.066 μ F的二级麦克思发生器对低感陶瓷电 容器组($C = 0.054 \mu$ F)进行脉冲充电,并通过 通道开关对激光器放电。图 6 给出不同电压 下激光输出的变化。从图中可见,电压为80~ 100 V 时激光输出功率最大,而当V = 150 V 时激光输出略有下降。上述结果与图 2 给出 的结果相符合,因为V = 100 V 时流速分布 比V = 150 V 时更为平坦。



根据流速测量值,当电压从 60 V 上升到 150 V,流速从 15 m/s 上升到 25 m/s。我们 可以认为在流速从 15~25 m/s 范围内,激光 器均能正常运转。在以下的实验中,我们一 般维持每秒 20 m 的流动速度。

作者之一^[5]曾对静态重复频率放电准 分子激光放电的热效应进行研究,根据该文 提出的放电气体热膨胀模型,当重复频率达 每秒10次时,热效应使输出功率降为不考虑 热效应情况预期值的一半左右。在本文的横 向流动情况下,热效应已由气体循环系统克 服。图7的实线给出激光输出功率与重复频 率之间的关系。从图中可见,激光输出功率 随重复频率线性增长,作为比较,图中同时 给出静态条件下的输出特性(虚线)。在每秒 10次条件下,当 HCl:Xe:Ne=1:6:857,总 气压为3.9atm 时,最大输出功率达10W。

图 8 给出 Ne 气压力对激光输出功率的 影响,当维持 HOI=3.5 Torr, Xe=30 Torr 时,改变 Ne 气的压力,激光输出功率随 Ne 气压力的增大而增长。图中二条曲线分别对

· 637 ·



应二种放电电压: 64 kV 和 54 kV。在这二种情况下,器件最大效率均为 0.9% 左右。

从图 8 我们可以看到器件的效率随工作 气体中氛气压力增大而增大。对于氙气分压 的影响,我们维持 HCl 的浓度为 3.5 Torr, 氖气压力为 2 atm,使氙气分压从 10 Torr 提 高到 30 Torr,激光输出功率随之线性增长。 图 9 给出氙气压力对激光输出功率的影响。 值得指出的是由于整个器件容积较大(大于 200 1⁸),而氙气的价格又比较昂贵,气体成份 最佳化的工作尚没有进行得很完善。

四、讨论

1. 随着重复频率的提高,激光放电与X 射线预电离之间的同步显得逐渐重要。我们 用OK-19 示波器同时检测不同重复频率下 二者之间的抖动时间。实验结果表明,在每 秒 5 次时,抖动时间为 50~60 ns; 当重复率 为每秒 8 次时,抖动时间为 90~100 ns; 进 一步将重复频率提高到每秒 10 次,抖动时 间为 120~130 ns。根据我们过去对放电泵 浦 XeCl 激光的 X 射线预电离动力学的分 析^[53],在较低的 HCl 浓度下

[HCl] ≤0.15%,

选择适当的延迟时间,例如 0.8 µs。当延迟 时间从 500 ns 变化到 1200 ns 时(抖动时间 为 700 ns),激光输出能量变化小于±5%。 在重复率运转下,随着重复频率的变化,单脉 冲能量变化为±10% 略大于静态时的变化 值,其原因可能与激光放电产生激波影响有 关。因此,在我们的实验条件下,上述抖动时 间并不影响激光器的输出特性,当然,为了进 一步提高重复频率,在电路上改进设计,减小 抖动时间是有利的。

2. 我们测量了横流情况下激光束的方向性,发现与静态平脉冲情况下基本一致,为4mrad左右。

(下转第645页)



射一级光通过,得到一定的密度提取(如图7)。 it. The exterimental results show a significant increase A the line of the store A net year of the stored 三、讨 论 [1] H. K. Lin, J. W. Goodman; Appl. Opt., 1976, 从实验结果看, 这种组合矩形光栅的

halftone 屏确实能对图象等密度分割假彩色

(上接第638页)

3. 用光电检测器及高速示波器拍摄 308 nm 激光波形。在每秒 5~10 个脉冲情 况下, 10个以上脉冲在示波照片上完全重 叠,其半高度全宽度约为85ns。上述结果表 明,该器件在重复频率下运转,输出信号幅度 持In、P的化学计量比,是一 比较稳定。

在器件设计中,得到本所查鸿逵、沈俊泉 同志的帮助,谨此致谢。



处理,并可以通过不同的频谱滤波得到一定 的密度提取。

这种屏对图象编码过程是一步完成的, 比G. Indebetouw 提出的第一种方法要简 单得多。不过,这种屏分割密度区的范围是 一定的, 要得到不同的密度区分割就需要 在制作 halftone 屏时控制不同的曝光,与 G. Indebetouw 提出的第二种屏相比, 两者 编码都是一次完成的,但他所用的屏制作比 较麻烦,尤其是对多层次密度分割,其屏的制 作更为困难。因为这时最高频率将与灰度层 次n和屏的基频有关系 fo×2n-1,同时,用这 种屏对图象编码时对接受的分辨率也有较高 要求。这些问题在我们的方法中都不存在。

对石敏同志在工艺上的帮助表示感谢。

- [2] G. Indebetouw; Appl. Opt., 1977, 16, No.7, 1951,
- [3] G. Indebetuw; Journal of Optics, 1978, 9, No.1, 1.

献

- [1] R. T. Young et al.; Proceeding OSA Conf. on Excimer Lasers. Ed. by C. K. Rhodes et al., AIP 1983, p. 266.
- [2] Tim Mcgrath; Solid State Technology, 1983, 26, 165.
- [3] M. Moretti; Laser and Applications, 1985, 4, No 6, 50.
- [4] 郑承恩; 《中国激光》, 1984, 11, No. 5, 276.
- [5] 楼祺洪等;《中国激光》, 1985, 12, No. 1, 20.